



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种降低氮化镓纳米线阵列晶体缺陷密度的方法

文献类型: 专利

作者 姜辛, 刘宝丹

发表日期 2016-03-16

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 姜辛, 刘宝丹

中文摘要 一种降低氮化镓纳米线阵列晶体缺陷密度的方法

公开日期 2016-03-16

申请日期 2012-07-06

语种 中文

专利申请号 201210234053.0

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78740>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 姜辛, 刘宝丹. 一种降低氮化镓纳米线阵列晶体缺陷密度的方法. 2016-03-16.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
8	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。